

## 파장 가변 DBR LD 제작

### Fabrication of Tunable DBR(distributed-Bragg-reflector) LD(laser diode)

오수환, 조호성, 김정수\*, 박경현, 이철욱, 박문호

한국전자통신연구원 정보통신원천기술연구소 광송수신소자팀

\*한국전자통신연구원 정보통신원천기술연구소 광전소자팀

osh@etri.re.kr

WDM 네트워크의 구축을 가능케 하는 핵심광소자로서 발진파장이 WDM 파장 영역을 포함할 수 있는 파장 가변광원에 대한 연구가 활발하게 진행되고 있다. 이러한 파장 가변광원은 WDM trunk 망의 광송신기에 있어서 파장 가변 기능에 의한 임의 파장채널을 설정할 수 있는 광원으로 활용될 뿐만 아니라 광교환용 파장변환기의 여기 광원으로 사용되며, 또한 광수신기에서 광신호를 선별 검출하기 위한 기준 광원으로 이용된다. 본 연구에서는 파장 가변 DBR (distributed-Bragg-reflector)-LD<sup>(2)</sup>를 제작하고 그 특성을 조사해 보았다.

그림 1은 제작된 DBR-LD의 개략도를 나타내고 있다. 활성영역과 위상제어 영역, DBR 영역으로 구분되며, 각각의 길이는 300μm, 200μm, 300μm이다. 도파로 구조는 도파로 역할을 하는 층과 활성층 역할을 하는 층을 수직으로 접적시킨 2중도파로 구조로 되어있다. 0.7% 압축응력을 가진 well과 0.35% 인장응력을 가진 barrier로 된 응력완화 MQW 활성층을 사용하였다. 도파로는 1.43μm InGaAsP층을 사용하였으며, 4번의 MOVPE 성장을 통해 PBH (planar buried heterostructur) 구조의 DBR-LD를 제작하였다.

제작된 DBR-LD를 CW로 구동시켰을 때의 I-L 특성 및 각 주입 전류 레벨에 따른 스펙트럼 특성을 그림 2에 나타내었다. 그림 2의 I-L 특성에서 1과 2사이, 2와 3사이에서 kink현상이 나타났다. 1과 2사이에서 스펙트럼을 측정한 결과 모드 호핑 현상이 나타나지 않았지만, 2와 3사이에서는 모드 호핑 현상이 나타남을 알 수 있다.

그림 3에 DBR-LD의 파장 가변 특성 및 스펙트럼 특성을 나타내었다. 활성층의 주입전류는 60mA로 하고, 위상 제어 영역에 전류를 1~25mA로 가변 시켰으며, DBR영역에 그림과 같이 전류를 주입하면서 파장 변화를 측정한 데이터를 그림에 나타내었다. 그 결과 DBR의 주입전류가 50mA이내에서 파장 가변은 7.2nm로 나타났다. 그리고 SMSR 특성을 측정한 결과 35dB이상으로 나타났다.

이상으로 DBR-LD를 제작한 결과 파장 가변 특성이 7.2nm로 나타났으며, SMSR특성이 35dB이상으로 나타남을 알 수 있었다.

#### 참고문헌

1. M.S.Borella, J.P.Jue, D.banerjee, B.Ramamurthy, and B.Mukherjee, "Optical components for WDM light networks," Proc.IEEE, vol.85, no.8, pp.1274~1307, 1997.
2. S.MURATA, I.MITO, K.KOBAYASHI "Tuning ranges for 1.5μm wavelength tunable DBR lasers" Electronics Letters, vol.24, no.10, pp.577~579, 1988

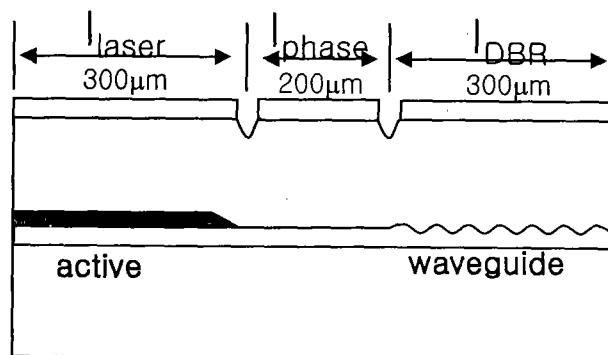


그림 1.  $1.55\mu\text{m}$  MQW PBH DBR-LD의 개략도

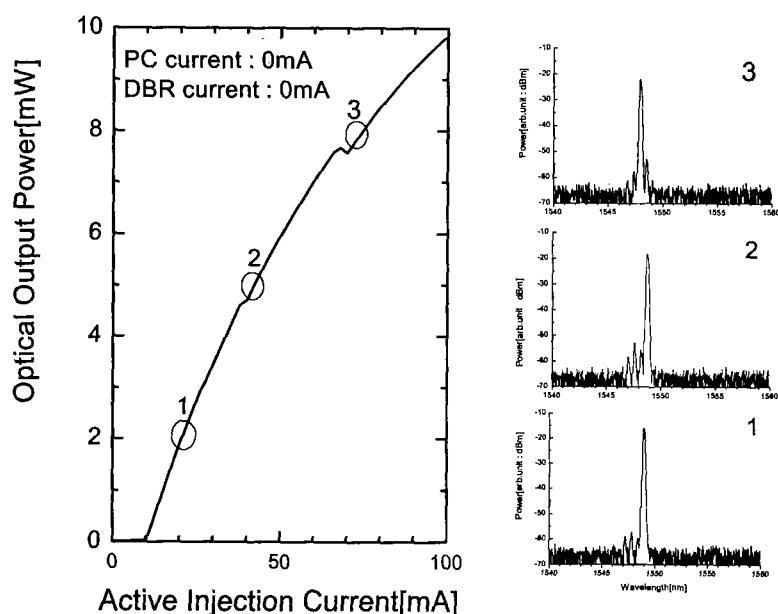


그림2. 제작된 DBR-LD의 I-L 및 스펙트럼 특성

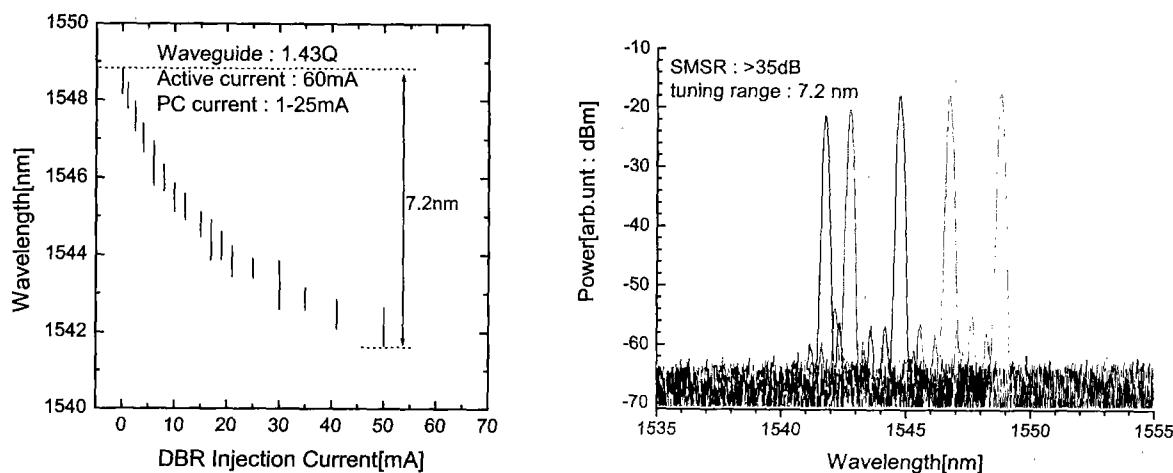


그림3.  $1.43\mu\text{m}$  InGaAsP 도파로를 사용한 DBR-LD의 파장가변 특성 및 스펙트럼 특성